

г. **Караганда**, ул. Алиханова 37, офис 108
г. **Астана**, ул. Ауэзова, 33/1, офис 210

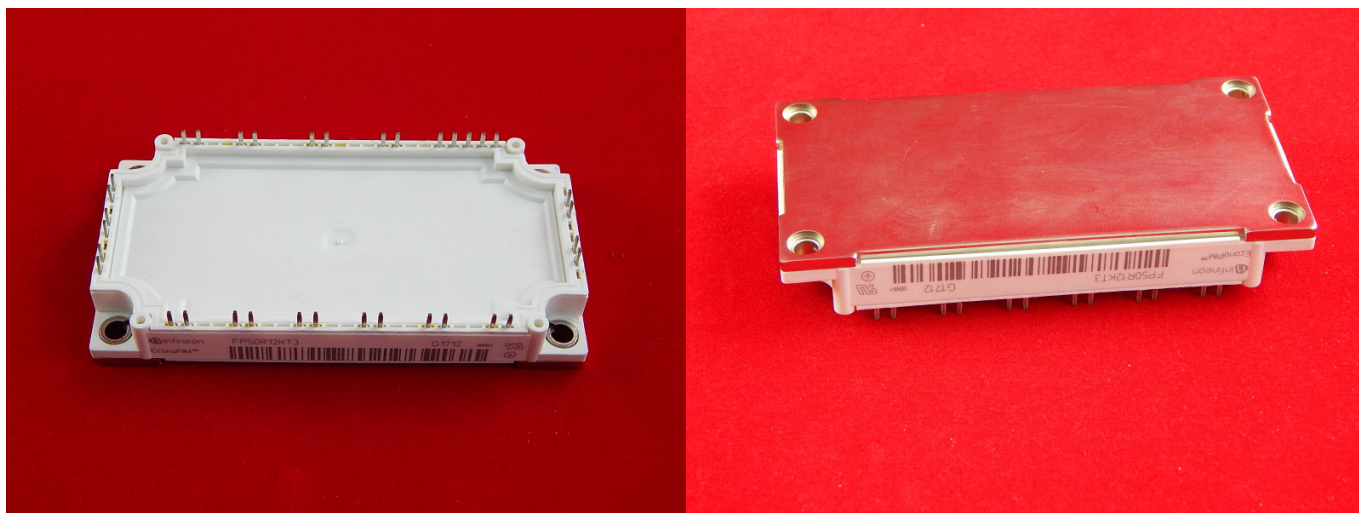
E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 13422

Цена в прайсе: 51261 тг.

FP50R12KT3 Модули биполярных транзисторов с изолированным затвором (IGBT)



Модули биполярных транзисторов с изолированным затвором (IGBT) N-CH 1.2KV 75A

Товар по предзаказу. Срок поставки 3-5 недель

Категория продукта: Модули биполярных транзисторов с изолированным затвором (IGBT)

Продукт: IGBT Silicon Modules

Конфигурация: Hex

Напряжение коллектор-эмиттер (VCEO), макс.: 1200 V

Непрерывный коллекторный ток при 25 C: 75 A

Минимальная рабочая температура: - 40 C

Максимальная рабочая температура: + 125 C

Высота: 17 mm

Длина: 122 mm

Ширина: 62 mm

Вид монтажа: Screw

Максимальное напряжение затвор-эмиттер: +/- 20 V

Другие названия товара №: FP50R12KT3BOSA1 SP000100445